

新型低温粒子探测器NTD-Ge 传感器的研发

薛明萱

核探测与核电子学国家重点实验室 中国科学技术大学

高能物理分会 2021.08.16-20 山东 青岛



▶无中微子双贝塔衰变 ▶低温粒子探测器 ▶NTD-Ge传感器研发 ▶总结



无中微子双贝塔衰变



中微子的绝对质量大小、Majorana属性、轻子数破缺、物质-反物质不对称起源

- 能谱法: 末态两个电子的动能和在衰变Q值处;
- 径迹+能谱法: 末态两个电子共顶点, 且动能和位于Q值处。

0νDBD国际研究现状



低温粒子探测器——低温量热器

- 粒子与物质相互作用
 - 信息载体: 电子-离子, 电子-空穴, 闪烁荧光, 声子



弹性碰撞: 粒子沉积能量绝大部分(~90%)最终转 换为声子发射,产生"热"

非弹性碰撞: 粒子沉积能量少部分(<10%)转换为 电子-离子(空穴)对,或者荧光

- ・闪烁探测技术(Nal晶体)
 - 光产额: 40000荧光光子/MeV
 - 波长: ~400 nm (~3 eV)
 - 荧光光子总能量: 0.12 MeV (~12%)
 - ~88%的能量直接转化为热量(声子),被
 自身吸收的荧光光子能量仍然会转化为
 热量(声子)



低温量热器

- 低温探测技术
- 基于声子(或以声子为媒介的)探测的粒子探测器,称为低温粒子探测器

LTD-Low Temp. Detector

CPD-Cryogenic Particle Detector

- "声子" (或次级的准粒子)数正比于能量沉积
- 原则上,各种介质都可以用来做低温探测器(LTD)的探测元件
- 1949年物理学家使用毫米级氮化铌在15K温度下观测到单α事件,标志着低温量热器 被首次应用到粒子物理学科

"The rapid technical developments of last years and their outstanding features make these detectors very attractive in a variety of field ranging from fundamental research to applied science." (2015)

1987年以来,LTD的物理和相关技术成为物理界公认 和关注的一个研究领域。

低温量热器——典型应用

• 应用 天文学、粒子物理与原子核物理、原子物理学、量子技术新前沿等等
 ✓ X射<u>线天文学</u>



✓ 暗物质粒子寻找



✓ 中微子弹性相干散射







低温晶体量热器—— $0\nu\beta\beta$ 探测

・低温晶体量热器 $0\nu\beta\beta$ 探测原理——能谱法



✓ 吸收体材料选择广泛,验证更多理论预测具有 $0\nu\beta\beta$ 的核素

- ✓ "源=探测器",无能量损失,极高探测效率,
- ✓ 极好的能量分辨率,探测媒介子——声子,5.3keV@2615keV (CUPID-Mo)
- ✓ 极好的粒子鉴别能力,抑制本底, "光-热"两相读出

低温晶体量热器—— $0\nu\beta\beta$ 探测

•低温晶体量热器 $0\nu\beta\beta$ 探测原理——能谱法



- 低温晶体量热器核心组成
 - 吸收体, 粒子通过与吸收体原子碰撞, 把能量沉积在吸收体内
 - - 温度传感器,测量吸收体的温度变化信号,两者之间有极好的热连接

 - 低温恒温器(热沉),用来偏置、稳定传感器的工作温度区间

NTD-Ge低温传感器

✓ 中子核嬗变掺杂锗传感器(Neutron Transmutation Doped Ge thermistors)

Five stable isotopes	Doped process	Туре
⁷⁰ ₃₂ Ge (3.052b)	${}^{70}_{32}Ge + n \rightarrow {}^{71}_{32}Ge \xrightarrow{EC} {}^{71}_{31}Ga + v_e \ (T_{1/2} = 11.43d)$	Ga acceptors form p-type
⁷² ₃₂ Ge	$^{72}_{32}Ge + n \rightarrow ^{73}_{32}Ge$ (stable)	-
⁷³ ₃₂ Ge	$^{73}_{32}Ge + n \rightarrow ^{74}_{32}Ge$ (stable)	-
⁷⁴ ₃₂ Ge (0.519b)	${}^{74}_{32}Ge + n \rightarrow {}^{75}_{32}Ge \xrightarrow{\beta^-}_{33}{}^{75}_{33}As + \overline{v_e} \ (T_{1/2} = 82.8min)$	Donors n-type
⁷⁶ 32 (0.154b)	${}^{76}_{32}Ge + n \rightarrow {}^{77}_{32}Ge \xrightarrow{\beta^-}_{33}{}^{77}_{33}As + \overline{v_e} \ (T_{1/2} = 11.3hrs)$	Donors
	$\stackrel{\beta^{-}}{\to} {}^{77}_{34}Se + \bar{v_e} \ (T_{1/2} = 38.8 hrs)$	n-type

- 净载流子浓度: $N_A N_D = N_{\frac{71}{31}Ga} (N_{\frac{75}{33}As} + 2 \times N_{\frac{77}{34}Se})$
- 蛙跳传导机制(Hopping Conduction) 在足够低温温度下(<1 K),电子作为载流子将从一个 能级跃迁到另一个能级,实现半导体热敏电阻属性

NTD-Ge低温传感器



NTD-Ge低温传感器技术研发路线



- 已进行高纯锗圆晶切割、表面处理、封装、辐照等操作
- 目前正在冷却/放射性检测阶段

401所CARR堆辐照

- 中国先进研究堆(China Advanced Research Reactor, CARR)
- •本次实验辐照功率10.327MW(2-5E18/cm²)
- 辐照时间2020年12月22日14:14至2020年12月25日06.43
- 实际辐照时长64小时29分钟
- 中子辐照积分通量





密封装进铝盒





NTD-Ge放射性活度测试

• 低本底HPGe谱仪测试辐照后HPGe片能谱图



NTD-Ge辐照通量检测

- 辐照过程无剂量监测片
- 采用Ge自身放射性标定-

-半衰期相对较长&信号相对干净

	Gamma and	X-ray radiation	<u>n</u> :	
$1/2- \frac{g.s}{32}Ge$ 11.43d	Ener (ke	gy V)	Intensity (%)	Dose (MeV/Bq-s)
$Q(gs) = 232.49 \ keV$	XR l	1.1	1.52 % 5	1.68E-5 5
	XR ka2	9.225	13.3 % 5	0.00123 5
	XR kal	9.252	26.1 % 10	0.00242 9
	XR kß3	10.26	1.66 % 6	1.71E-4 6
$3/2 71C_{\pi}$	XR kβl	10.264	3.24 % 11	3.33E-4 12
3 <u>1</u> 6a	XR kß2	10.366	0.0275 % 10	2.85E-6 10

- 模拟与实验相结合
- 根据探测器测得的kX-ray反推中子辐照积分通量
- 选用三种探测器:

微结构气体探测器MMD 硅漂移探测器SDD 溴化镧闪烁体探测器LBC 高能物理分会

微结构气体探测器MMD测试

・MMD探测器灵敏面积15x15 cm², 1.1cm气隙,气体: 95%Ne+5%iC4H10



・测试结果

A RooPlot of "x"





微结构气体探测器MMD测试Geant4模拟

• MMD探测器建模



硅漂移探测器SDD测试

SDD探测器



Be窗 ϕ 7mm×12.5 μ m

多层准直φ4.66mm 厚度100μm钨W+35μm铬Cr+15μm钛Ti+75μm铝AI

硅晶体5mm×5mm×500um

测试能区2-30 keV 能量分辨率120 eV@5.9keV (Fe55)

• 实验室测试实物图







5-1

硅漂移探测器SDDGeant4模拟

SDD探测器建模



中子辐照积分通量结果

• 初步测试结果



• 硅漂移探测器SDD与微结构气体探测器MMD测试检测通量结果一致





•基于声子探测的低温粒子探测器对稀有衰变物理有其独特优势

- 极好的能量分辨率(5.3keV@2615keV)
- 极低的探测器能量阈值
- 独特的粒子鉴别能力
- 中子辐照核嬗变掺杂高纯锗(NTD-Ge)半导体低温传感器研发
 - 工作温度mK深冷低温,动态范围大,在粒子物理/核物理领域应用前景广泛
 - 已完成反应堆中子辐照,并实验获得实际辐照通量
 - 预期进行后续技术工艺,并在mK稀释制冷机平台内测试
- HPGe片可以作为一种新的反应堆中子通量监测片
 - ⁷⁰Ge具有相对适中的热中子俘获截面, ⁷¹Ge具有相对适中的放射性半衰期
 - 特征X-ray为10 keV量级,匹配探测器性价比高
 - 冷却1-2年后,可以作为半导体电子学器件回收使用,环境友好型

谢谢